

Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα	Χαράλαμπος Δημητριάδης
<i>Θέση</i>	Καθηγητής
<i>Σπουδές</i>	-Πτυχίο Φυσικής, ΑΠΘ, Απρίλιος 1974. -Μάστερ, Solid State Electronics, Electrical Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England, December 1976. -Διδακτορικό, Solid State Electronics, Electrical Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England, July 1979.
<i>Επιστημονική Εμπειρία</i>	- Φυσική και τεχνολογία ημιαγωγικών διατάξεων - Θόρυβος χαμηλών συχνοτήτων ημιαγωγικών διατάξεων - Αξιοπιστία ημιαγωγικών διατάξεων
<i>Ερευνητικό Έργο</i>	- Τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFTs) - Αναλυτικά συμπαγή μοντέλα ρεύματος και χωρητικότητας νανο-τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών και FDSOI νανο-τρανζίστορ. - Μοντέλα θορύβου χαμηλών συχνοτήτων σε νανο-τρανζίστορ απλής πύλης και πολλαπλών πυλών και FD-SOI MOSFETs. - Στατική και δυναμική μεταβλητότητα θορύβου χαμηλών συχνοτήτων σε νανο-τρανζίστορ MOSFETs. - Αριθμητική προσομοίωση νανο-τρανζίστορ MOSFETs πολλαπλών πυλών.
<i>Πέντε Κυριότερες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις</i>	- E.G. Ioannidis, S. Haendler, A. Pahron, N. Planes, F. Arnaud, R.A. Bianchi, M. Haond, D. Golanski, J. Rosa, C. Fenouillet-Beranger, P. Perreau, C.A. Dimitriadis, G. Ghibaudo, Low frequency noise variability in high-k/metal gate stack 28nm bulk and FD-SOI CMOS transistors, IEDM 2011, Washington, USA. - A. Tsormpatzoglou, N.A. Hastas, S. Khan, C.A. Dimitriadis, and M. Hatalis, Comparative study of active-over-metal and metal-over-active amorphous IGZO thin-film transistors with low frequency noise measurements, IEEE Electron Dev. Lett. 33, p. 555 (2012). - N. Fasarakis, A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, I. Pappas, K. Papathanasiou, M. Bucher, G. Ghibaudo, and C.A. Dimitriadis, Compact model of drain current in short-channel triple-gate FinFETs, IEEE Trans. Electron Dev. 59, 1891 (2012). - E.G. Ioannidis, C.A. <u>Dimitriadis</u> , S. Haendler, R.A. Bianchi, J. Jomaah, and G. <u>Ghibaudo</u> , Improved analysis and modeling of low-frequency noise in nanoscale MOSFETs Solid State Electron. 76, 54 (2012). - N. Fasarakis, A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, I. Pappas, K. Papathanasiou, M. Bucher, G. Ghibaudo, and C.A. Dimitriadis, Compact capacitance model of undoped or lightly-doped ultra-scaled triple-gate FinFETs, IEEE Trans. Electron Dev. 59, 3306 (2012).